

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成19年7月5日(2007.7.5)

【公開番号】特開2005-39261(P2005-39261A)
 【公開日】平成17年2月10日(2005.2.10)
 【年通号数】公開・登録公報2005-006
 【出願番号】特願2004-192542(P2004-192542)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/768 (2006.01)
G 0 9 F 9/00 (2006.01)
G 0 9 F 9/30 (2006.01)
H 0 1 L 21/288 (2006.01)
H 0 1 L 21/3205 (2006.01)
H 0 1 L 29/786 (2006.01)
H 0 1 L 21/336 (2006.01)
G 0 2 F 1/1368 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/90 A
 G 0 9 F 9/00 3 3 8
 G 0 9 F 9/30 3 3 8
 H 0 1 L 21/288 Z
 H 0 1 L 21/88 K
 H 0 1 L 29/78 6 1 2 C
 H 0 1 L 29/78 6 1 6 K
 G 0 2 F 1/1368

【手続補正書】

【提出日】平成19年5月21日(2007.5.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

導電層上に形成された絶縁膜に前記導電層が露出する開口部を設け、
液滴吐出法によって前記開口部に選択的に導電性の微粒子を充填し、
前記絶縁膜上の前記導電性の微粒子を充填した開口部を含む位置に配線を形成し、前記
導線層と前記配線を電氣的に接続させることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項2】

導電層上に形成された絶縁膜に前記導電層が露出する開口部を設け、
液滴吐出法によって前記開口部に選択的に柱状の導電体を形成し、
前記絶縁膜上の前記導電体を形成した開口部を含む位置に配線を形成し、前記導線層と
前記配線を電氣的に接続させることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項3】

請求項1または請求項2において、配線を形成した後、熱処理を行い前記配線表面の平坦性を増すことを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項4】

導電層上に形成された絶縁膜に前記導電層が露出する開口部を設け、

前記開口部が形成された前記絶縁膜上に前記導電性微粒子を散布して前記開口部内に前記導電性微粒子を充填し、

前記導電性微粒子の充填後、超音波振動を与え、前記開口部外の前記導電性微粒子を除去することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項5】

請求項1乃至請求項4のいずれか一項の半導体装置の作製方法を用いたことを特徴とする表示装置の作製方法。